

IEEE EDS Kansai Chapterの皆様
IEEE Kansai Section の皆様

2016年12月26日
IEEE EDS Kansai Chapter Chair 浦岡行治
Vice Chair 中村 孝

下記の通り、第16回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」を開催致します。
会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

会議名: 第16回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」
主 催: IEEE Electron Devices Society Kansai Chapter
日 時: 2016年1月30日(月) 10:00~15:15
会 場: 大阪工業大学 うめきたナレッジセンター
場 所: 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1
 グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワー C9階

プログラム: 次ページ以降参照
公用語: 日本語
会 費: 無料(事前登録不要)

【お問い合わせ先】
IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 前元 利彦 (大阪工業大学; toshihiko.maemoto@oit.ac.jp)

=====

<ご講演頂く皆様へ>

講演時間: 20分 + 質疑: 5分 (全て日本語)

使用器具: 講演で使用していただくPCは原則ご持参ください。もしご都合が悪いようでしたら、事前に鎌倉(阪大; kamakura@si.eei.eng.osaka-u.ac.jp)までご連絡ください。その場合、Power Pointデータを事前に上記アドレス宛お送りいただくか、当日USBスティックメモリをご持参ください。

当日、特別な資料をご用意いただく必要はありません。

開会挨拶 [10:00 - 10:05]

浦岡 行治 (奈良先端科学技術大学院大学)

Session I. Sensor, Solar Cell, and Emerging Devices [10:05-11:45]

座長: 積 知範(オムロン)

- 10:05** **Temperature and Illuminance Detections by Hybrid-type Carrier-generation Sensors using n-type and p-type Poly-Si TFTs [AMFPD]**
K. Kito, H. Hayashi, S. Kitajima, T. Matsuda, M. Kimura
Ryukoku Univ.
- 10:30** **Terahertz Emission from Individual Subcells in a Triple Junction Solar Cell Excited by a Wavelength Tunable Pulsed Laser [SSDM]**
S. Hamauchi¹, Y. Sakai¹, T. Umegaki¹, A. Ito², H. Nakanishi², I. Kawayama¹,
H. Murakami¹, M. Tonouchi¹
¹*Osaka Univ.*, ²*SCREEN Holdings Co., Ltd.*
- 10:55** **Time-Resolved Micro-Raman Stress Spectroscopy for Single-Crystal Silicon Resonators Using a MEMS Optical Chopper [IEEE J. MEMS]**
T. Tsuchiya¹, Y. Kogita¹, A. Taniyama¹, Y. Hirai¹, K. Sugano², O. Tabata¹
¹*Kyoto Univ.*, ²*Kobe Univ.*
- 11:20** **Evolution of Hydrogen-related Defect States in Amorphous In-Ga-Zn-O Analyzed by Photoelectron Emission Yield Experiments [AMFPD]**
K. Hayashi, A. Hino, H. Tao, M. Ochi, H. Goto, T. Kugimiya
Kobe Steel, Ltd.

— 昼食 [11:45 - 13:00] —

Session II. Power and Compound Semiconductor Devices [13:00 - 14:15]

座長: 加藤 貴敏 (村田製作所)

- 13:00** **Current-collapse-free Operations up to 850 V by GaN-GIT utilizing Hole Injection from Drain [ISPSD]**
S. Kaneko, M. Kuroda, M. Yanagihara, A. Ikoshi, H. Okita, T. Morita, K. Tanaka,
M. Hikita, Y. Uemoto, S. Takahashi, T. Ueda
Panasonic Corp.
- 13:25** **Impact Ionization Coefficients in 4H-SiC Toward Ultrahigh-Voltage Power Devices [IEEE T-ED]**
H. Niwa, J. Suda, T. Kimoto
Kyoto Univ.
- 13:50** **Embedded Source Field-Plate for Reduced Parasitic Capacitance of AlN/GaN MIS-HEMTs on Si Substrate [SSDM]**
K. Chikamatsu, M. Akutsu, T. Tanaka, S. Takado, K. Sakamoto, N. Ito, K. Nakahara
ROHM Co., Ltd.

— 休憩 [14:15 - 14:30] —

Session III. CMOS Process, Device, and Circuit [14:30-14:55]

座長: 岡田 健治 (パナソニック・タワー・ジャズ セミコンダクター)

14:25 **Negative Bias Temperature Instability Caused by Plasma Induced Damage in 65 nm Bulk and Silicon On Thin BOX (SOTB) Processes [IRPS]**

R. Kishida, A. Oshima, K. Kobayashi
Kyoto Inst. Tech.

AWARD授与式 [14:55-15:10]

上田 尚宏 (リコー)

閉会挨拶 [15:10-15:15]

浦岡 行治 (奈良先端科学技術大学院大学)